

Член-корреспондент АН СССР В. Г. ЛЕВИЧ, Б. М. ГРАФОВ

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК В БИНАРНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Представляет принципиальный интерес провести исследование картины распределения поля и вещества в простейшей электрохимической системе — ячейке с бинарным электролитом при наличии обратимой электродной реакции. Ниже рассматривается импеданс такой системы.

Распределение поля и концентраций в ячейке даются известными уравнениями

$$j_+ = D_+ (-\partial n_+ / \partial x + z_+ E n_+ e / kT); \quad (1)$$

$$j_- = D_- (-\partial n_- / \partial x - z_- E n_- e / kT); \quad (2)$$

$$\partial E / \partial x = 4\pi e (z_+ n_+ - z_- n_-) / \epsilon; \quad (3)$$

$$\partial j_+ / \partial x + \partial n_+ / \partial t = 0, \quad \partial j_- / \partial x + \partial n_- / \partial t = 0, \quad (4)$$

где j_+ , j_- ; n_+ , n_- ; z_+ , z_- — соответственно потоки, концентрации и зарядности ионов; E — электрическое поле.

Рассмотрение поляризации ячейки слабым синусоидальным током мы проведем, используя представление о резком переходе между областью диффузного слоя и диффузионной областью. Чтобы исключить влияние естественной конвекции, будем считать, что электролиз проводится в капилляре длиной L , на открытом конце которого поддерживается исходная концентрация ионов n_+^0 и n_-^0 (1). Любую величину можно представить в виде суммы равновесной величины (будем ее отмечать прямой чертой) и переменной добавки (будем ее отмечать волнистой чертой). В диффузионной области $x^{(d)} \ll x \leq L$ с учетом условия электронейтральности из (1), (2) и (4) можно получить

$$z_+ \tilde{n}_- = z_+ \tilde{n}_+ = z_+ \tilde{n}_+^{(d)} e^{-k_\omega(x-x^{(d)})}; \quad (5)$$

$$z_+ \tilde{n}_+^{(d)} = \frac{\tilde{j}_+^{(d)} D_+^{-1} + \tilde{j}_-^{(d)} D_-^{-1}}{k_\omega (z_+^{-1} + z_-^{-1})}; \quad k_\omega = \left[i\omega \frac{(D_+ z_+)^{-1} + (D_- z_-)^{-1}}{z_+^{-1} + z_-^{-1}} \right]^{1/2}, \quad (6)$$

где ω — частота синусоидального тока $I = I_0 \exp(i\omega t)$. При написании (5) и (6) предполагалось, что $|k_\omega^{-1}| \ll L$ и поэтому искалось решение в неограниченной области. Величины с индексом (d) относятся к границе диффузного и диффузионного слоя. Из (1) и (2) с учетом того, что $\bar{E} = 0$, $\bar{n}_+ = n_+^0$, $\bar{n}_- = n_-^0$ для падения потенциала в диффузионной области можно получить

$$\tilde{\varphi}^{(d)} - \tilde{\varphi}^{(L)} = (z_+ e \tilde{j}_+^{(d)} - z_- e \tilde{j}_-^{(d)}) \lambda^{-1} L + (D_- - D_+) \lambda^{-1} e z_+ \tilde{n}_+^{(d)}, \quad (7)$$

где λ — проводимость раствора. Первое слагаемое в (7) представляет собой омические потери в растворе постоянной концентрации. Мы это слагаемое дальше учитывать не будем, подразумевая, что омические потери включены в некоторое омическое сопротивление, соединенное последовательно с ячейкой. Второе слагаемое в (7) связано с концентрационными изменениями

в диффузионной области

$$(\tilde{\varphi}^{(d)} - \tilde{\varphi}^{(L)})_{\text{конц}} = e (D_- - D_+) \lambda^{-1} \tilde{n}_+^{(d)} z_+. \quad (8)$$

Перейдем теперь к рассмотрению области диффузной части двойного слоя $0 \leq x \leq x^{(d)}$. Мы будем считать, что в электрохимической реакции принимают участие положительные ионы, а электрический заряд в диффузионном слое определяется отрицательными ионами. Уравнение Пуассона (3) можно переписать в виде

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x} = - \frac{4\pi e^2 z_-}{\varepsilon \theta} n_- \quad \left(\mathcal{G} = \frac{eE}{\theta}; \theta = kT \right). \quad (9)$$

Концентрация отрицательных ионов возрастает к электроду. Прохождение электрического тока практически не изменит их распределения по закону Больцмана

$$n_- = n_-^{(d)} e^{z_-(\psi - \psi^{(d)})} \quad \left(\mathcal{G} = - \frac{\partial \psi}{\partial x} \right). \quad (10)$$

Чтобы формально получить (10), нужно в (2) опустить член с током. Если частота переменного тока ω много меньше частоты релаксации заряда в двойном слое ω_0 , то, как показывают оценки, это можно сделать. Порядок ω_0 равен $D_- \kappa_-^2$, где $\kappa_-^2 = 4\pi e^2 n_0 / (\varepsilon \theta)$. Мы будем предполагать, что неравенство $\omega \ll \omega_0$ хорошо выполняется.

Используя (10), можно получить решение (9) в виде

$$\frac{1}{2} \mathcal{G}^2 = \frac{4\pi e^2}{\varepsilon \theta} n_-^{(d)} (e^{z_-(\psi - \psi^{(d)})} - 1) + \frac{1}{2} (\mathcal{G}^{(d)})^2.$$

Постоянная интегрирования определена из условия смыкания с диффузионной областью. Учитывая малость электрического поля в диффузионной области и быстроту изменения экспоненциальной функции, можно написать, что для большей части диффузионного слоя, во всяком случае при $\psi - \psi^{(d)} \gg 1$, выполняется соотношение

$$\frac{1}{2} \mathcal{G}^2 = \kappa_-^2 \frac{n_-}{n_-^0} = \kappa_-^2 \frac{n_-^{(d)}}{n_-^0} e^{z_-(\psi - \psi^{(d)})}. \quad (11)$$

Ток смещения в гельмгольцевской части двойного слоя обусловлен колебаниями плотности отрицательных ионов в диффузионной части двойного слоя. По мере удаления от электрода ток смещения будет переходить в электрический ток отрицательных ионов. Поэтому ток отрицательных ионов на границе с диффузионным слоем будет равен току смещения в плоскости наибольшего приближения. Величины, относящиеся к этой плоскости, будут отмечаться звездочкой

$$\tilde{j}_-^{(d)} = - \frac{\varepsilon \theta}{4\pi e^2 z_-} i \omega \tilde{\mathcal{G}}^*. \quad (12)$$

Так как положительные ионы не участвуют в образовании заряда двойного слоя и ток смещения не создается колебаниями их плотности, то ток положительных ионов не будет меняться с расстоянием в пределах двойного слоя

$$\tilde{j}_+^{(d)} = i \tilde{j}_+^*. \quad (13)$$

Используя (11) и (13), решение уравнения (2) можно записать в виде

$$n_+ = n_+^{(d)} e^{-z_+(\psi - \psi^{(d)})} + \tilde{j}_+^{(d)} e^{\frac{z_-}{2}(\psi - \psi^{(d)})} \left[\kappa_- D_+ (z_+ - z_- / 2) \sqrt{2 \frac{n_-^{(d)}}{n_-^0}} \right]^{-1}. \quad (14)$$

При этом считали, что $z_+ > z_- / 2$ и воспользовались большим значением $\psi - \psi^{(d)}$ (случай $z_+ < z_- / 2$ мы оставляем в стороне). Соотношения, связывающие малые переменные величины, могут быть найдены из (10), (11), (14)

непосредственным дифференцированием. Таким образом, имеем

$$\begin{aligned}\tilde{\Psi}^* - \tilde{\Psi}^{(d)} &= \frac{1}{z_-} \frac{\tilde{n}_-^*}{n_-^0} e^{-z_- \tilde{\Psi}^*} - \frac{1}{z_-} \frac{\tilde{n}_-^{(d)}}{n_-^0}; \\ \bar{\mathcal{E}}^* \tilde{\mathcal{E}}^* &= \frac{\kappa_-^2 \tilde{n}_-^*}{n_-^0};\end{aligned}\quad (15)$$

$$\tilde{n}_+^* = (z_+^{-1} + z_-^{-1}) z_+ \tilde{n}_+^{(d)} e^{-z_+ \tilde{\Psi}^*} - \frac{z_+}{z_-} \bar{n}_+^* e^{-z_- \tilde{\Psi}^*} \frac{\tilde{n}_-^*}{n_-^0} + \frac{\tilde{f}_+^{(d)} e^{-\frac{z_-}{2} \tilde{\Psi}^*}}{D_+ \kappa_- (z_+ - z_-/2) \sqrt{2}}. \quad (16)$$

В случае обратимой реакции для концентрации разряжающихся ионов можно написать

$$n_+^* = \bar{n}_+^* e^{z_+ \Delta \Psi}; \quad \Delta \Psi = \varepsilon \delta_r (\bar{\mathcal{E}}^* - \tilde{\mathcal{E}}^*) / \varepsilon_r,$$

где δ_r и ε_r — толщина и диэлектрическая постоянная гельмгольцевского слоя. Отсюда для переменных величин находим

$$\tilde{n}_+^* = \bar{n}_+^* z_+ \Delta \tilde{\Psi}; \quad \Delta \tilde{\Psi} = \varepsilon \delta_r \tilde{\mathcal{E}}^* / \varepsilon_r. \quad (17)$$

Используя (6), (12), (13), (15), (16), (17), можно получить для комплексной проводимости ячейки выражение

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{i \omega C_{\text{дв}} + \frac{[z_+ \bar{n}_+^* + k_{\omega}^{-1} D_-^{-1} e^{-z_+ \tilde{\Psi}^*} \theta i \omega C_{\text{дв}} (e^2 z_-)^{-1}] z_+ e^{2\theta - 1}}{k_{\omega}^{-1} D_+^{-1} e^{-z_+ \tilde{\Psi}^*} + e^{-z_- \tilde{\Psi}^*/2} [D_+ \kappa_- \sqrt{2} (z_+ - z_-/2)]^{-1}}}{1 - \frac{D_+ k_{\omega}^{-1}}{n_+^0 (z_+ D_+ + z_- D_-)} \frac{z_+ \bar{n}_+^* - i \omega \theta C_{\text{дв}} e^{-z_- \tilde{\Psi}^*/2} [e^2 z_- D_- \kappa_- \sqrt{2} (z_+ - z_-/2)]^{-1}}{k_{\omega}^{-1} e^{-z_- \tilde{\Psi}^*/2} [\kappa_- \sqrt{2} (z_+ - z_-/2)]^{-1}}},\end{aligned}\quad (18)$$

где $C_{\text{дв}} = \varepsilon_r / (4\pi \delta_r)$.

При написании (18) опущена как малая по сравнению с единицей величина $\varepsilon_r (\varepsilon \delta_r \tilde{\mathcal{E}}^*)^{-1}$. В случае достаточно малого значения ω , когда выполняется условие

$$L_{\omega} = |k_{\omega}^{-1}| \gg L_{\text{дв}} = \kappa_-^{-1} [V\sqrt{2} (z_+ - z_-/2)]^{-1} e^{(z_+ - z_-/2) \tilde{\Psi}^*}, \quad (19)$$

из (18) можно получить

$$\sigma = \left(\frac{z_+ D_+ + z_- D_-}{z_- D_-} \right)^2 i \omega C_{\text{дв}} + \frac{z_+ D_+ + z_- D_-}{z_- D_-} \frac{z_+^2 e^2}{\theta} n_+^0 k_{\omega}. \quad (20)$$

При выводе (20) считалось, что величина $|\varepsilon_r k_{\omega}^2 L_{\text{дв}} [\varepsilon \delta_r \kappa_-^2]^{-1}|$ является малой по сравнению с единицей. Если выполняется неравенство, обратное (19), но частота еще не очень велика, так что $|k_{\omega}^2 L_{\text{дв}} \kappa_-^{-1}| \ll 1$, то из (18) получим

$$\sigma = i \omega C_{\text{дв}} - \frac{z_- D_-}{z_+ D_+ + z_- D_-} \frac{e^2 z_+^2 n_+^0 D_+}{\theta L_{\text{дв}} k_{\omega} L_{\text{дв}}} + \frac{e^2 z_+^2 n_+^0 D_+}{\theta L_{\text{дв}}}. \quad (21)$$

Наконец, в случае еще больших частот, когда наряду с неравенством, обратным (19), выполняется неравенство $|k_{\omega}^2 L_{\text{дв}} \kappa_-^{-1}| \gg 1$, получим из (18)

$$\sigma = i \omega C_{\text{дв}} + e^2 z_+^2 n_+^0 D_+ \theta^{-1} L_{\text{дв}}^{-1}. \quad (22)$$

Заметим, что выражение для $L_{\text{дв}}^{\text{в}}$ в (19), полученное нами для случая переменного тока, совпадает с выражением для эффективной длины диффу-

зии в двойном слое при постоянном токе, полученным в работе (2). Колебания отрицательных ионов, связанные с наличием тока смещения, в диффузионной области в силу электронейтральности раствора приводят к колебаниям разряжающихся (положительных) ионов. При соблюдении (19) эти колебания легко могут дойти до электрода и вызвать ток, по порядку величины совпадающий с током смещения. Первое слагаемое в (20) отвечает этому току и току смещения. Если значение величины $[(z_+D_+ + z_-D_-)/z_-D_-]^2$ велико по сравнению с единицей, то емкость, не зависящая от частоты, аномально велика. При выполнении (19) колебания плотности положительных ионов, отвечающие условию (17), легко проникают через область двойного слоя в диффузионную область, вызывая там колебания, ведущие к появлению в (20) второго слагаемого, вид которого совпадает с видом обычного фарадеевского импеданса, свойства которого хорошо известны (3).

Если выполняется неравенство, обратное (19), то связь между колебаниями положительных ионов в гельмгольцевской плоскости и колебаниями в диффузионной области нарушается. В этом случае, как показывает (22), емкость ячейки определяется зарядной емкостью, а сопротивление не зависит от частоты и определяется колебаниями положительных ионов в пределах двойного слоя.

В заключение отметим, что изложенная выше теория естественным образом переносится на случай, когда заряд в двойном слое определяется положительными ионами, а разряжаются ионы отрицательные.

Институт электрохимии
Академии наук СССР

Поступило
3 V 1962

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ А. Н. Фрумкин, В. С. Багоцкий, З. А. Иофа, Б. Н. Кабанов, Кинетика электродных процессов, М., 1952. ² В. Г. Левич, ДАН, 67, 309 (1949).
³ П. Делаксэй, Новые приборы и методы в электрохимии, ИЛ, 1957.